

Тип	Материал	Спектральная область чувств., мкм	$\lambda_{\text{макс.}}$ чувств., мкм	Интегральная чувств. по эталонному излучателю мА/лм	Темновой ток, мкА	Пороговый ПОТОК или пороговая освещенность лм	Постоянная времени, с	Площадь чувствительного слоя, мм ²	Напряжение питания, В
ФД-1	Ge	0,4...1,9	1,6	20	30	$1,5 \cdot 10^{-10}$	10^{-5}	5,0	15
ФД-2	Ge	0,4...1,9	1,6	10...20	25; 40 (40° С)	$(2,8...1,4) \cdot 10^{-10}$	10^{-5}	1,1	30
ФД-3	Ge	0,4... 1,9	1,6	20	15; 110 (60° С)	$1,1 \cdot 10^{-10}$	10^{-5}	3,0	10
ФД-3А	Ge	0,4...1,9	1,6	10	10; 65 (60° С)	$1,8 \cdot 10^{-10}$	$5 \cdot 10^{-8}$	3,0	10
ФД-4	Ge	0,4... 1,9	1,6	20	30	$1,5 \cdot 10^{-10}$	10^{-5}	5,0	20
ФД-К1	Si	0,5... 1,2	1,0	3	3	$3 \cdot 10^{-10}$	10^{-5}	—	20
ФД-6К	Si	0,5... 1,2	1,0	$1,4 \cdot 10^{-2}$ мкА/ лк 20	1:7 (75° С)	$2,8 \cdot 10^{-11}$	10^{-6}	1	20
ФД-А2	Si	0,5... 1,2	1,0	6...7	3	$(2-5) \cdot 10^{-13}$ Вт	10^{-6}	—	20
ФД-5Г	Ge	0,4... 1,9	1,6	—	8	$5 \cdot 10^{-9}$ лм/Гц 1/2	$3 \cdot 10^{-5}$	—	15
ФД-7К	Si	0,4...1,2	0,8	0,47					
КФ-ДМ	Si	0,5... 1,2	1,0	$1,5 \cdot 10^{-2}$ А/лк, 7,5... 15	5/1	$5 \cdot 10^{-8}$ $(3,8...7,6) \cdot 10^{-11}$	$1 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-6}$	—1...2	20/20
ФД-8К	Si	0,5... 1,2	1,0	$8 \cdot 10^{-3}$ мкА/лк	1; 2(80°С)	$1,4 \cdot 10^{-10}$	$7,5 \cdot 10^{-6}$	—	20
ФД-8К	Si	0,5...1,2	1,0	4	3	$2,5 \cdot 10^{-10}$	$7,5 \cdot 10^{-6}$	2	20
ФД-9Э111	Ge	0,4... 1,8	1,5	17	10	—	$1,2 \cdot 10^{-7}$	—	10
ГД-20	Ge	0,4...1,9	1,55	$>3 \cdot 10^{-6}$ мА/лк	<10	500 лк	10^{-5}	—	45
ГД-50	Ge	0,4...1,9	1,55	$>5 \cdot 10^{-8}$ мА/лк	<10	300 лк	10^{-5}	—	45
ФД	GaAs	0,3...0,95	0,85	1...1,5	-	$6 \cdot 10^{-11}$	$(1...2) \cdot 10^{-3}$	—	—

ФД	GaAs	0,3...0,95	0,85	1...1,5	-	$6 \cdot 10^{-11}$	$(1...2) \cdot 10^{-3}$	—	—
ФД	GaAs	0,3...0,95	0,85	1...1,5	—	$2,8 \cdot 10^{-12}$ Вт	$1,35 \cdot 10^{-3}$	1,5X1,5	—
ФТ-1	Ge	0,4...1,9	1,6	170...500	300	$5 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-4}$	—	3